PAT-NO:

JP02001230368A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2001230368 A

TITLE:

PACKAGE STRUCTURE OF INTEGRATED CIRCUIT

PUBN-DATE:

August 24, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ONISHI, OSAMU

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP2000039680

APPL-DATE:

February 17, 2000

INT-CL (IPC): H01L025/065, H01L025/07, H01L025/18

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To double the mounting density, concerning a film carrier type of semiconductor part.

SOLUTION: The package structure of this integrate circuit is of such a

structure that a semiconductor chip 4 having a bump electrode is mounted on one

side and a semiconductor chip 5 manufactured in mirror inversion is mounted on

the other side in opposition, from both sides of a film carrier tape,

film carrier tape having double-faced wirings 2 and 3. The mirror-

semiconductor chip 5 is one which is arranged so that the bump electrode may be

positioned in the same place, in opposition to the bump electrode position of

the semiconductor chip 4, whereby it can double the mounting density and the

wiring density and equalize the load at connection between the bump electrode and the wiring conductor of the film carrier tape.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001—230368 (P2001—230368A)

(43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.CL.7

識別記号

PΙ

テーマコート*(参考)

H01L 25/065

25/07

25/18

H01L 25/08

Z

審査請求 有 請求項の数6 OL (全 4 頁)

(21)出顧番号

特顧2000-39680(P2000-39680)

(22)出廣日

平成12年2月17日(2000.2.17)

(71)出窟人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 大西 修

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100088328

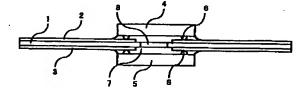
弁理士 金田 暢之 (外2名)

(54) 【発明の名称】 集積回路のパッケージ構造

(57)【要約】

【課題】 フィイルムキャリア型半導体部品に関し、その実装密度を2倍とする。

【解決手段】 本発明の集積回路のパッケージ構造は、 両面配線2と3を有するフイルムキャリアテープを用い、フイルムキャリアテープの両面からバンプ電極を有する半導体チップ4を一方の面に、もう一方の面に、ミラー反転し製造された半導体チップ5を相対向して搭載する構造である。ミラー反転された半導体チップ5は、 半導体チップ4のバンプ電極位置と対向して同一箇所にバンプ電極が位置するようにしたもので、これにより、 実装密度と配線密度を倍増し、バンプ電極とフィルムキャリアテープの配線導体間の、接続時の荷重を均一にすることができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面電極にバンプを形成した半導体チップを、両面に金属箔配線を有するフィルムキャリアテープに搭載してなる集積回路のパッケージ構造において、前記両面の金属箔導体の少なくとも半導体チップ表面バンプと接続される電極部分が、表裏対向して同一位置に形成され、その表裏対向電極にそれぞれ半導体チップを搭載することを特徴とする集積回路のパッケージ構造。

【請求項2】 前記フィルムキャリアテープの両面に搭載される半導体チップの表面電極バンプ位置が、

対向して同一位置となるようにしたことを特徴とする請求項1に記載の集積回路パッケージ構造。

【請求項3】 前記表面電極バンプ位置が、

一方の半導体チップを、他方の半導体チップのミラー反転して製造することで、対向して同一位置となるようにしたことを特徴とする請求項2に記載の集積回路パッケージ構造。

【請求項4】 前記表面電極にバンプを形成した半導体 チップが、

表面電極にボンディングパッドを形成した後にバンプを 20 形成した半導体チップである請求項1に記載の集積回路 パッケージ構造。

【請求項5】 前記両面の金属箔導体の少なくとも半導体チップ表面バンプと接続される電極部分が、表裏対向して同一位置に形成されるために、貫通孔を前記フィルムキャリアテープに設けることを特徴とする請求項1に記載の集積回路バッケージ構造。

【請求項6】 前記表裏対向電極にそれぞれ半導体チップを搭載する際に、収縮特性を有する異方性樹脂によりボンディングすることを特徴とする請求項1に記載の集 30 積回路パッケージ構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フィルムキャリア ー型半導体部品に関し、特に、半導体チップ搭載の集積 回路のパッケージ構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、フィルムキャリアテープの両面に 半導体素子を実装した公開公報が多く見られる。実開昭 6197857号公報に記載されている半導体装置は、 フィルムキャリアテープの両面に形成された回路配線基 板に2個の半導体チップがその回路形成面が、回路配線 基板側に向くように、フィルムキャリアテープの両面に 実装されていることを特徴とする半導体装置である。特 開昭62-205636号公報に記載されている半導体 装置の製造方法と、特開昭63-136642号公報に 記載されている二層式半導体集積回路は、フィルムキャ リアテープの片面に形成された配線導体であるリードフ レームあるいはフィンガーリードの両面に半導体チップ をバンプなどにより接続する例が公示されている。ま た、特開昭64-77135号公報に記載されている半 導体装置と、特開平4-279052号公報に記載され ている半導体集積回路装置においても、フィルムキャリ アテープの片面に形成された配線導体であるリード端子 あるいはインナーリードの両面に半導体チップをバンプ などにより接続する例が公示されている。これら公示例 は、全て半導体チップの実装密度を上げるためになされ たものであり、配線の実装密度を上げることを目的にし ているものではない。

10 [0003]

【発明が解決しようとする課題】すなわち、図3に示すように、上記公示例のいずれも、フィルムキャリアの両面に半導体チップを搭載して実装密度を向上させているが、同一平面に設けられた配線導体の両面から半導体チップのバンプを接続するため、実装半導体チップを増やすことはできても、配線密度の向上は期待できない。

【0004】また、実開昭6197857号公報に記載されている半導体装置は、フィルムキャリアテープの両面に形成された回路配線基板に2個の半導体チップを実装するので配線密度の向上が期待できるが、考案の目的及び効果が高密度の実装と半導体チップ表面の保護であり、考案を示す第1図および第2図からは配線密度の向上を想像することは不可能である。

【0005】また、特開昭63-136642号公報と特開平4-279052号公報に記載されている半導体集積回路装置は、表裏に搭載される半導体チップの表面電極が、相対向して同一箇所にないため、フイルムキャリア配線電極と半導体チップ表面バンブとの間に、接続のための安定した荷重をかけることができないため、接続が不完全となる危険性がある。

【0006】この問題を解決するため、相対向する部位 に電気的に絶縁されたダミーの表面バンプを設けること も可能であるが、半導体チップそのもののサイズを、ダミーの表面電極の分だけ大きくする必要があり、本来の 趣旨である実装密度の向上に逆行するものである。

【0007】以上により、フイルムキャリアの配線密度 と搭載される半導体チップの双方の条件が満たされなけ れば実装密度の向上は達成できない。

【0008】本発明の目的は、フィイルムキャリア型半 40 導体部品に関し、その配線密度と半導体チップの搭載密 度を同時に約2倍とすることで、実装密度の向上を達成 しようとするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の集積回路のバッケージ構造は、表面電極にバンプを形成した半導体チップを、両面に金属箔配線を有するフィルムキャリアテープに搭載してなる集積回路のパッケージ構造において、両面の金属箔導体の少なくとも半導体チップ表面バンプと接続される電極部分が、表裏対向して同一位置に形成50 され、その表裏対向電極にそれぞれ半導体チップを搭載

することを特徴とする。

【0010】また、フィルムキャリアテープの両面に搭載される半導体チップの表面電極バンプ位置は、対向して同一位置となるようにしたことを特徴とする。

【0011】さらに、表面電極バンプ位置は、一方の半 導体チップを、他方の半導体チップのミラー反転して製 造することで、対向して同一位置となるようにしたこと を特徴とする。

【0012】また、表面電極にバンプを形成した半導体 チップは、表面電極にボンディングパッドを形成した後 10 にバンプを形成した半導体チップであつても良い。

【0013】さらに、両面の金属箔導体の少なくとも半 導体チップ表面バンプと接続される電極部分は、表裏対 向して同一位置に形成されるために、貫通孔をフィルム キャリアテープに設けても良い。

【0014】さらにまた、表裏対向電極にそれぞれ半導体チップを搭載する際に、収縮特性を有する異方性樹脂によりボンディングしても良い。

[0015]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい 20 て図面を参照して説明する。図1は本発明の集積回路のパッケージ構造を示す断面図である。

【0016】本集積回路のパッケージ構造は、フイルムキャリアテープ1と、フイルムキャリアテープ1の表面に形成された配線導体群2と、フイルムキャリアテープ1の裏面に形成された配線導体群3と、配線導体群2にバンプ電極6を介して半導体チップ4と、同じく配線導体群3に他のバンプ電極6を介して半導体チップ5と、パッケージ構造としてこれら要素を一体とする樹脂7から構成されている。

【0017】フイルムキャリアテープ1に搭載される半 導体チップ4は、その表面にバンプ電極6を有する。半 導体チップ5は半導体チップ4をミラー反転して製造さ れたもので、同じくバンプ電極6を有する。

【0018】なお、この半導体チップ5は、半導体チップ4のバンプ電極に対向した位置に、半導体サイズに無駄なく対向できるものであれば、必ずしもミラー反転して製造されたものでなくてもよい。

【0019】これらの半導体チップ4、5のバンプ電極6は、フィイルムキャリアテープ1の配線電極2と3に、半導体チップ4、5の裏面や周囲から加えられた熱と、半導体チップ4、5の裏面からの荷重により熱圧着法で接続し搭載される。

【0020】樹脂7は、半導体チップ4、5の表面保護 と、両面の半導体チップ4、5とフィルムキャリア1を 機械的に保持するための樹脂であり、貫通穴8はフイル ムキャリアテープの貫通穴として両面の半導体チップ 4、5の固定と配線導体群2、3の分離に有益である。 したがって、貫通穴8は、配線導体群2、3がそれぞれ 分離していれば無くても良い。

【0021】また、図2に示すように、半導体チップ4 は、表面電極にボンディングパッドを形成した後にその 表面にバンプ電極6を有していても良い。

【0022】さらに、半導体チップ4、5の表面保護 と、両面の半導体チップ4、5とフィルムキャリア1を 収縮特性を有する異方性樹脂により機械的に保持する。 【0023】

【発明の効果】フイルムキャリアテープの両面に配線導体を設けることで、配線密度を従来の約2倍に向上させ、そのフイルムキャリアテープの両面配線の一方の面に半導体チップ4と、もう一方の面に半導体チップ4と同一機能でミラー反転して製造された半導体チップ5を搭載することで、半導体チップの搭載密度も2倍とすることができる。すなわち、フイルムキャリアテープの両面に、配線導体を設けることで、電気的に独立した配線を従来の約2倍得ることができる。

20 【0024】また、この配線導体は、スルーホール等で必要に応じてフイルムキャリア両面の配線導体を接続することができる。

【0025】次に、半導体チップに関しては、フイルムキャリアテープの一方の面に半導体チップ4を、もう一方の面ににミラー反転して製造された半導体チップ5を対向して搭載することで、搭載密度を2倍にできる。

【0026】また、ミラー反転して製造された半導体チップを用いることで、フイルムキャリアテープの両面から、半導体チップの表面電極を対向して位置させることができるため、安定した均一の接続荷重をかけることが可能となり、十分な接続信頼性を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例における集積回路のパッケージ構造を示す断面図である。

【図2】第2の実施例における集積回路のパッケージ構造を示す断面図である。

【図3】従来の集積回路のパッケージ構造を示す断面図 である。

【符号の説明】

- 40 1 フィルムキャリアテープ
 - 2、3 導体配線群
 - 4、5 半導体チップ
 - 6 バンプ電極
 - 7 エポキシ等の樹脂
 - 8 貫通穴
 - 9 ボンディングパッド
 - 11 フィンガー電極

4

